OPTICAL RECORDING MEDIUM AND OPTICAL RECORDING METHOD

Publication number: JP2003054135

Publication date: 2003-02-26

Inventor: MIZUSHIMA TETSUO; YOSHINARI JIRO; KURIBAYASHI ISAMU

Applicanti

Applicant: TDK CORP

Classification:
- international: B41M5/26: G1187/045; G1187/025: G1187/025; G

- international:

Application number: JP20010272671 20010907

Priority number(s): JP20010272671 20010907; JP20010170055 20010605

Report a data error here

Abstract of JP2003054135

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a winte-once by so optical recording medium excellent in loop-term presentation reliability and regenerated natability, capable or selecting a recording replaced metalling plays specifiability entrappears and investigated from a vide verwelping replan and enabling lays specifiability entrappears and proving recording medium to a milliary proving specific proving and excellent plays a selection of the view-one by so optical recording medium to a milliary proving specific proving and specific proving specific prov

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-54135

(P2003-54135A) (43)公開日 平成15年2月26日(2003. 2. 26)

				(40) 240	IH TMIOTE	12011 (2000)	E. 207
(51) Int.Cl.7		識別紀号	FΙ			テーマコート*(参	考)
B41M	5/26		G11B	7/0045	A	2H11	1
G11B	7/0045	i		7/125	С	5 D 0 2	9
	7/125			7/24	511	5 D 0 9	0
	7/24	511			5 2 2 D	5 D 1 1	9
		5 2 2	B41M	5/26	x		
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL (全 1-	4 頁)
(21)出願番号	}	特順2001-272671(P2001-272671)	(71)出願人	. 0000030	067		
				ティー	ディーケイ株式会	社	
(22)出願日		平成13年9月7日(2001.9.7)		東京都中	中央区日本橋1丁	目13番1号	
			(72)発明者	水島	哲鄉		
(31)優先権主	E張番号	特順2001-170055 (P2001-170055)		東京都中	中央区日本橋一丁	目13番1号	ティ
(32)優先日		平成13年6月5日(2001.6.5)		ーディー	ーケイ株式会社内		
(33)優先権主	三張国	日本 (JP)	(72)発明者	吉成	欠 鄉		
					中央区日本橋一丁 一ケイ株式会社内	目13番1号	ティ
			(74)代理人	1000828	365		
				弁理士	石井 陽一		
						最終頁	~ tile <
			1			ACCRECATE	- PE -

(54) 【発明の名称】 光記録媒体および光記録方法

(57)【要約】

【課題】 長棚保存信頼性および再生耐火性に使れ、か 、記録/再生波長を広い波長域から選択することが可 能で、また、高速、高密度退録が可能な追記型光記録媒 体を提供する。また、このような追記型光記録媒体を多 層光記録媒体に適用したときの適切な記録方法を提供す る。

【解決手段】 第1の福記場限と第2の周記場限とをそれぞれ少なくとも1層合む機能能験解を有1、第1の期記録間の主張分金額および第2の測記場間の主張分金額は、拠点がいずれも500℃以上であり、第1の期記録間の主張分金額と第2の測記場場の主張分金額とは、減合したときに、それぞれの拠点より高い視点をもつ合金が生成しるものであり、レーザーと一へ規制はより、それぞれの測記場限に含有される主張分金属が建筑して混合し、この混合により、反射率が不可逆的に変化した影響マークが地震もおる半環状を表

(2) 開2003-54135 (P2003-50A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 1種の金属を主成分とする第1の副配録 層と、前記1種の金属以外の金属を主成分とする第2の 副記録層とを、それぞれ少なくとも1層含む積層記録層 を有1。

を有し、 第1の副記録階の主成分金属および第2の副記録層の主 成分金属は、融点がいずれも500℃以上であり、

第1の副記録層の主成分金属と第2の副記録層の主成分 金属とは、混合したときに、それぞれの融点より高い融 点をもつ合金が生成しうるものであり。

積層記録層に記録用レーザービームを照射することによ り、それぞれの副記録層に含有される主成分金属が拡散 して混合し、この混合により、反射率が不可逆的に変化 した記録マークが形成される光記録媒体。

【請求項2】 第1の副記録層および第2の副記録層 が、いずれも結晶質である請求項1の光記録媒体。

【請求項3】 第1の副記録層の主成分がA1であり、 第2の副記録層の主成分がSbである請求項1または2 の光記録媒体。

【請求項4】 積層記録層中において、原子比Sb/A 1が1/3~3である請求項3の光記録媒体。

【請求項5】 記録マークの反射率の熱安定性が、記録マークを除く領域の反射率の熱安定性よりも高い請求項1~4のいずれかの光記録媒体。

【請求項6】 記録用レーザービームの照射により副記録層の少なくとも1層が溶融する請求項1~5のいずれかの光記録媒体。

【請求項7】 積層記録層の両側に、無機材料からなる 無機保護層が存在する請求項1~6のいずれかの光記録 媒体

【請求項8】 少なくとも2層の記録層が積層され、他 の記録層を通して照射されるレーザービームによって記 録/再生が行われる記録層が存在する媒体であり、少な くとも1層の記録層が前記積層記録層である請求項1~ 7のいず力かの光記録響か

【請求項9】 他の記録層の記録/再生に用いるレーザービームが透過する記録層のうち少なくとも1層が、前記積層記録層である請求項8の光記録媒体。

【請求項10】 請求項8または9の光記録媒体に記録 する方法であって、

特定のマーク長の信号を記録するに際し、すべての記録 層において記録パレスストラテジを同一とし、かつ、各 記録層ごとに記録用レーザービームのパワーを最適に創 御する光記録方法。

【請求項11】 請求項8または9の光記録媒体に記録 する方法であって、

特定のマーク長の信号を記録するに際し、すべての記録 層において記録用レーザービームのパワーを同一とし、 かつ、各記録屑ごとに記録用レーザービーム照射時間を 最適に削削する光記録方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、追記型記録層を有する光記録媒体と、この光記録媒体に記録する方法とに関する.

[0002]

【従来の技術】近年、高密度高速記録が可能な光記録媒体が注目されている。

[0003] 現在、追認型や記録媒体の記録層として有 機色素を塗布したものが普及している。しかし有機色素 は、低速記録では問題はないが、高速直録を行うために は記録経度が不十分である。また、記録素度を上げるた めたレーザ淡長を聞くしていった場合、使用できる有機 色素が各波長で限定されること、および、青色以下の 長での色素の合成が難しいといった問題を学んでいる。 [0004] 無線料料を用いた追認型や記録媒体として は、孔あけ記録や、積層膜における起散を用いた記録に より反射率を変化させて情報を記録する方法等が提案さ れている。

【0005] 孔永付記録が行われる解除は、通常、丁e やBi等の低敗点金属(または合金)からなる記録膜を 有する、孔あけ記録の際には、記録膜にレーザビームを 照射することによって記録膜を局部的に溶散させる。溶 酸した低脱点金属は表面張力によって盛り上がり、一 が、その盛り上がりに囲まれて機味は盛む、この組入だ 側域が記録マークとして利用される。このような孔あけ 記録媒体では、溶接金質が動きが貯すないために、いわか ゆるエアーサンドイッチ排きはよる必要形ちみ、いわか

ゆるエアーサンドイッチ構造とする必要がある。そのた 、製造コストが高くなるほか、CD(コンパクトディ スク)やDVD(Digital Versatile Disk)のような再 生専用媒体と再生互換性を確保することが実質的に不可 能であり、実用性が低い。 【0006】一方、積層した金属膜の拡散・混合による

100061 − 7. 税権レス並の際の処成・成合による 反射率変化を利用した記憶媒体は、孔が打型で用いるエ アーサンドイッチ構造のような複雑な構造をとる必要が 無く、低コスト化が可能な媒体として注目を集めてい

【0007】例えば、特公平4-838号公報には、低 触点金額(1 n、S n)と間相反応を示す第1か金属戦 (Au、A s)と、前部延廃止金属を主成分とする第2 の金属販を模型した記録材料にレーザビームを照射する ととにより、前1の金属販と窓の金属販とを開射で反 応させる記録方法が記載されている。同公報には、低融 点金属として1 nを用いた場合には125℃で配料反応 が盗数に進み、また、S n = 用いた場合には180℃程 度で間根反応が進む旨が記載されている。このように比 物質が虚数でよりないました。このは影材料では、十分な 保存信酬性を確保することは困難である。また、低粧点 金属と制分合わせて用いられるA u きよびA s は、その 金属と前部反反応発度に比べましてあり、たかちって、こ

(3)開2003-54135 (P2003-5uE蹌繳

のような組み合わせにおける固相反応では拡散速度が遅 くなるので、高速記録には不向きである。

【0008】実公平6-32372号公開には、光学的 消衰機器の小さいGe、Te、Bi、Ti、Tiおよび これらを主成分とする第1の記録層と、これよりも大き な光学的消衰機をもつTe、Bi、Sn、Au、S b、As、Al、Inおよびそれらを主成分とする合金 の第2の記録層とを具備する光ディスクが記載されてい 。この光ディスクでは、光照時により両記録解が相互 拡散して単一層に変化する。同公報の実施例では、第1 の階膜(記録層)をGeから構成し、第2の滞腹(記録 層)をAlから開成している。

【0009】特開2000-187884号公報には、 ライトワンス型光記録媒体において、記録層が記録媒体 の基板側に設けた第1の記録層とその上に設けた第2の 記録層の2層からなり、レーザービームの照射により第 1の記録層を構成する元素の濃度と第2の記録層を構成 する元素の濃度とが逆転する現象を利用して記録を行う 光記録媒体が記載されている。第1の記録層を構成する 元素は、Sb、Ge、Bi、Te、Se、Siの少なく とも1種であり、第2の記録層を構成する元素は、1 n、Al、Gaの少なくとも1種である。同公報の実施 例では、第1の記録層をGeまたはその合金から構成 し、第2の記録層をA1またはその合金から構成してい る、同公報には、レーザービーム照射により相互拡散が 急激に進行するため、濃度の逆転が生じる旨が記載され ている。しかし、このようにレーザービーム照射部位 (記録マーク) において元素分布が偏り、安定した混合 状態となっていないのでは、十分な保存信頼性が得られ るとは思われない。

(0011) 特別中2-235789始公様には、A 収、Al、Ag、Pt、Pd、Ni、Cr、Cのから選 形された元素およびこれるの元素を含む合金から構成さ れる高い反射率をもつ層(反射層)と、カルコゲナイド (研収開生かは記録層)とを有する光学情報記録解析が 記載されている。同公報には、吸収層生たは記録層にお いて、カルコゲナイドに加え、Ge、Sn、In、S b、Pb、Cu、Ni、Pd、Co、Si、酸化物、受 体例、操作機を非なせても、い時が必要数されている。 同公報には、記録時に、反射層構成元素がカルコゲン化。 物を形成する旨が記載されている。同公報の実施例で は、Auからなる反射層とTeまたはこれとTeO。と の混合物からなる記録層との組み合わせ、Alからなる 反射層とTeからなる記録層との組み合わせ、NiCr からなる反射層とTeからなる記録層との組み合わせ、 Auからなる反射層とSb層およびTe層からなる記録 層との組み合わせを用いている。同公報記載の発明で は、反射層と記録層との反応により生成するカルコゲン 化物の融点が反射層の融点よりも低くなる(例えばAu の融点は1083℃で、AuTe2の融点は464℃) ため、記録マークの熱安定性が十分に高くはならない。 【0012】そのほかにも、特開平5-12711号公 報には、高反射率の元素と低融点元素とから構成された 第1の記録膜と、第1の記録膜中の低融点元素と合金を 生じるような元素を含有する第2の記録膜とを光ディス クが記載されている。同公報の実施例2では、AI-B i (原子比1:1)層とSb-Se (原子比1:1)層 とを精層している。この光ディスクにおける記録時の作 用は、A1-Bi層中のBiがSb-Se層側に拡散す ることによってAIが析出し、その部位で反射率が向上 するというものである。

【0013】上記各提案に示される媒体は、いずれも実 用化に至っていない。上記各媒体は、保存信頼性や再生 簡外性、高速記録について改善の余地があると考えられ る。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、長期除存信 類性および再生耐入性に優れ、かつ、記録/再生談長を 広い被長機から擬形することが可能で、また、高速、高 密度記録が可能な追記型光記録媒体を提供することを目 的とする。また、本発明は、このような追記型光記録媒 体を多層光記録媒体に関すしたときの適切な記録方法を 提供することを目的とする。

[0015]

- 【課題を解決するための手段】このような目的は、下記 $(1) \sim (11)$ の本発明により達成される。
- (1) 1種の金屋を主成分とする第1の副記録層と、 前記1種の金属以外の金属を主成分とする第2の副記録 層とを、それぞれ少なくと61層含化頻配設機をす し、第1の副記録層の主成分金属はおじ第2の副記録層 の主成分金属は、龍点かいずれ6500で以上であり、 第1の副記録層の主成分金属と第2の副記録層の主成分金属とは、混合したときに、それぞれの融点より高い融 点をもつ合金が生成しうるものであり、根配記録層に記 は関ローザービームを照射することにより、それぞれの 副記録層に含有される主成分金属が拡散して混合し、こ の混合により、反射率が不可選的に変化した記録マーク が形成される光記録媒体。
- (2) 第1の副記録層および第2の副記録層が、いず

(4) 間2003-54135 (P2003-50A)

れも結晶質である上記(1)の光記録媒体。

- (3) 第1の副記録層の主成分がA1であり、第2の 副記録層の主成分がSbである上記(1)または(2) の光記録媒体。
- (4) 積層記録層中において、原子比Sb/Alが1 /3~3である上記(3)の光記録媒体。
- (5) 記録マークの反射率の熱安定性が、記録マーク を除く領域の反射率の熱安定性よりも高い上記(1)~ (4)のいずれかの光記録媒体。
- (6) 記録用レーザービームの照射により副記録層の 少なくとも1層が溶融する上記(1)~(5)のいずれ かの光記録媒体。
- (7) 積層記録層の両側に、無機材料からなる無機保護層が存在する上記(1)~(6)のいずれかの光記録 健体
- (8) 少なくとも2層の記録層が積層され、他の記録 層を通して照射されるレーザービームによって記録/再 生が行われる記録層が存在する媒体であり、少なくとも 1層の記録層が前記積層記録層である上記(1)~
- (7)のいずれかの光記録媒体。
- (9) 他の記録層の記録/再生に用いるレーザービームが透過する記録層のうち少なくとも1層が、前記積層記録層である上記(8)の光記録媒体。
- (10) 上記(8)または(9)の光記録媒体に記録 する方法であって、特定のマーク長の信号を記録するに 際し、すべての記録層において記録パレスストラテジを 同一とし、かつ、各記録層ごとに記録用レーザービーム のパワーを長適に削御する光記録方法。
- (11) 上記(8)または(9)の光記録媒体に記録する方法なてあって、特定のマーク長の信号を記録するに際し、すべての記録層において記録用レーザービームのパワーを同一とし、かつ、各記録層ごとに記録用レーザービーム原明時間を最適に削削する光記録方法。
- 【0016】なお、前記特開2000-187884号 公報には、Sbからなる第1の記録層とAlからなる第 2の記録層とを組み合わせる選択肢が開示されている。 ただし、同公報に開示されているのはあくまでも選択肢 だけであり、この組み合わせで実際に媒体を作製して効 果を確認しているわけではない。同公報に実施例として 記載されているのは、Geまたはその合金からなる第1 の記録層と、A 1 またはその合金からなる第2の記録層 との組み合わせであり、本明細書において比較例として 示すように、この組み合わせでは本発明の効果は実現し ない。また、同公報には、レーザービーム照射により相 互拡散が急激に進行するため、濃度の逆転が生じる旨が 記載されているが、本明細書に実施例として示すよう に、本発明の媒体では、第1の副記録層構成元素と第2 の副記録層構成元素とはほぼ均一に混合し、濃度の逆転 は生じない。
- 【0017】ところで、特開平5-159352号公報

には、前記し欠乱か打電鉄が行われる爆体が定載されている。同公権記載の媒体は、多層構造の記録機を有し、
私態襲撃構成さる存襲拠が互いに溶離、混合したとき、
各種膜を構成する材料よりら溶散温度の高い合金または
金國間代合物が生成するものである。同公権記載の記録が 所定では、記録用エネルギービーA服営はより前部記録を 層を局部的に溶離して孔あり記録を行った後、記録用エネルギービームより低パワーレベルの保存処理用エネル オービームを、記録機の全線に関する。この保存処理 用エネルギービームの照射により、記録機全域が高融点 の合金または金属間化合物に変化するため、記録情報の の合金をたは金属間化合物に変化するため、記録情報の

[0018] 特開平5-159352号分構記載の媒体 は、記録販を構成する名薄膜が互いに溶線、混合したと き、谷葉原を構成する材料よりも溶積速度の高い合金ま たは金原間化合物が生成する点で、本売明の媒体に契値 する。しかし、同分解記載の技術に、孔が把影媒体で あり、孔あけ記録媒体は前途したように高コストであ り、また、実用性が低い、また、同公都の実施的では、 (1) Tre (根底m=4500) 酸と5 にm=23

2で)との組み合わせ、(2) 「毎度とお (m=2 7 1で)膜との組み合わせ、(3) 「毎度と I (m=2 7 1で)膜との組み合わせを用いている。このよう に各体膜の組みが低いと、高速環境下での保存時に記録 膜中において固相反応による拡散が進行して高能点金属 が生成されてしまうので、記録が不可能となってしまう。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の光記録媒体は、少なくと も1層の第1の雑記録層と、少なくとも1層の第2の部 記録層とをも複類記録解をする。第1の部記録配 第2の部記録解とは、相異なる1種の意像を主成分とす る。この積層記録解に記録用レーザービームを照射する と、れんぞれの雑記録解に容すされる主成分金減が、 解解域において拡散して混合する。この混合により生し 反び生成単版、服射領域の反射半を変化させらか。 ここを記録マークとして利用することができる。前記反 射率変化は不可逆的であるため、本沙明の媒体は追記型 の光記録媒体として利用することができる。前記反 別半変化は不可逆的であるため、本沙明の媒体は追記型 の光記録媒体として利用することができる。

【0020】以下、本発明の好ましい態様である、A1を主成分とする副記録層(以下、A1主成分層)と、Sbを主成分とする副記録層(以下、Sb主成分層)とをそれぞれ少なくとも1層合む積層記録層を有する媒体を中心に説明する。

[0021]記録マーク中において前草主成分を風は混合された状態となっており、金属門化舎物として存在するか、金属門化舎物と生成しなくても、少なくとも主成分金属門上が結合した状態の混合物として存在すると考えられる。例えば、A1主成分層と5り主成分層とからなる視頻距差層の場合、金属開化合物であるA15bが

(5) 開2003-54135 (P2003-50zA)

生成していると考えられる。ただし、AISbのような 金属間化合物は、結晶成長している必要はなく、電子線 回折によって検出できない程度の結晶質(微結晶状態) であっても本発明の効果は実現する。

【0022】本発明では、記録マーク中の反応生成物の 熱安定性が、記録前において副記録層が積層された状態 での熱安定性よりも高くなることが特徴である。具体的 には、記録マークが既に形成されている積層記録層に、 記録マークの形成が可能なパワーレベルの記録用レーザ ービームを照射したとき、積層記録層では前記混合が生 じて反射率が変化し、一方、既に形成されている記録マ ークは記録用レーザービーム照射により反射率が変化し ないことを意味する。A 1 の融点は6 6 0 ℃、S b の融 点は631℃であり、両者共に単体で熱的に十分に安定 であり、しかもレーザービーム照射による溶融が可能で ある。また、SbとAlとの反応により、それぞれの単 体よりも融点が十分に高く、低温と高温とで結晶構造が 変化しない安定な金属間化合物 A 1 S b (融点: 106 ○℃)が生成しうる。本発明ではこのように、各副記録 層に含有される主成分金属同士が混合したときに、それ ぞれの主成分金属の融点より高い融点をもつ合金(好ま しくは金属間化合物)が生成しうる必要がある。

【0023】そのため、本売明の媒体は、記録候た高温 環境下で保存しても、前記反応生成物からなる記録マー クが変化しにくく変定である。形成された記録マークを 読み出す際には、再生用レーザービームを照射する。再 生用レーザービームのソワーはは砂砂値いが、そのよう。 、奈変性性の低い記録マークでは、再生によって、特 、結構り返し再生によって記録マークが変化してしまう が、本発明の媒体では再生によっては記録マークは変化 しにくく、再生間火性に優れる。また、本売明の媒体で に記録マークを消してしまう現象(クロスイレータ) 、クロスイレータンを 、が、変現的に生しない。記録時、四段では 、のが表現れている。記録は、記録を 、のの記録マークを消してしまう現象(クロスイレータ チェックの記録マークを消してしまう現象(クロスイレータ チェックで表してい、高校憩に記録をプラックビッ ケを挟くすることができるので、高被態に記録に有効であ

【0024】これに対し、組成の相撲なる2層の金風層 をレーザービームによって脚時に加能して拡散する点で は同じであっても、拡散によって生成する生成物が非平 街状態である場合、例えば生成物が実態混合物や帯安定 構造をもの場合には、加熱により、あるいは空温での長 期間保存により予番状態への水態変化(例えば相分離) が生じる、そのため、非平耐水態の生成物からなる記録 マークは、本発明における記録マークに比べ機変変性が 著しく低くなり、再生耐火性および保存信頼性が悪くな 著しく低くなり、再生耐火性および保存信頼性が悪くな

【0025】副記録層は上記主成分金属だけを含有していてもよいが、他の元素が添加されていてもよい。各副記録層における主成分金属の含有量は、好ましくは80

原子%以上、より好ましくは90原子%以上である。副 記録解中における主成分企業の合有提が少なすると 熱安定の高い記録マークを形成することが困難となる。 【00261本等即では、Sb主成分解およびA1主成 分層を結晶質便として形成することが好ましい、Sb主 成分層およびA1主成分層を結晶質層として形成すれ ば、非晶質層として形成される場合に比べ反射率が高く なるため、記録マークを除く領域の反射率を高くするこ とができ、その結果、再生出力を高くすることができ る。

【0027】副記場層は、スパッタ法や素者法などの気相成長法により形成することが好まして、特にスパッタ法により形成することが好ましい。Sb主成分層をスパッタ法により形成する場合、Sb含有重が多ければ結晶質層として形成される。一方、Sbか結晶化を匿等する元素がある程度技上添加されていれば、Sb主成分層が結晶質として形成されずい、Sb主成分層が結晶質となるかは、Sb主成分層を軽温を行っている。Sb主成分層を軽温を関連して形成するためには、Sb有重を対ましくは30原子が以上とし、よらを打ましくは30原子が以上とし、さらがましくは30原子が以上とし、ならを指すとくは30原子が以上とし、さらがましくは30原子が以上とし、ならがまた。

【0028】 ただし、結晶質層として形成されうる組成 であっても、後述する多層が記録媒体に適用する場合の ように測記録層が厚さ数ナノメートル程度以下と薄い場 合には、Sb主成分層およびA1主成分層のいずれもが 微結晶構造となることがある。

【0029】A1主成分層に添加される元素としては、 Cr、Ti、Niなど、耐食性を向上させる金属元素の 少なくとも1種が好ましい。一方、Sb主成分層に添加 される元素としては、13 (IIIb)、14 (IVb)、1 5 (Vb)、16 (VIb) の各族に属する元素の少なくと も1種が好ましい。ただし、上述したように、Sb主成 分層はSbだけから構成されることが最も好ましい。 【0030】積層記録層中において、A1主成分層とS b 主成分層とは接していることが好ましいが、これらの 層の間に、他の元素を主成分とする介在層が存在してい てもよい。前記他の元素としては、A1主成分層または Sb主成分層において添加元素として用いられる前記元 素の少なくとも1種が挙げられる。また、介在層は、融 点が500~1000℃の範囲内にある化合物から構成 されていてもよい。上記介在層の厚さは、好ましくは5 nm以下、より好ましくは3nm以下である。介在層が厚す ぎると、A1とSbとの混合が妨げられることがある。 【0031】主成分金属の融点は、どの副記録層におい ても500℃以上とする。融点の低い主成分金属を含有 する副記録層が存在すると、再生時および高温環境下で

(6) 開2003-54135 (P2003-5u撮織

の保存時に、固相反応による拡散が進行してしまうた め、再生耐久性および保存信頼性が悪くなる。

【0032】積層記録層は、これを構成する各副記録層 の融点未満の温度においても固相反応により拡散を生じ させて反射率を変化させることが可能である。例えばA 1 主成分層とSb主成分層との組み合わせでは、400 ℃以上かつ融点未満の温度で十分な固相反応を生じさせ ることができる。ただし、高速で記録するためには、拡 散速度が速い液相反応による拡散を利用することが好ま しいので、記録用レーザービームを照射したときに、副 記録層の少なくとも一方が溶融することが好ましく、す べての副記録層が溶融することがより好ましい。その場 合に記録感度を高くするためには、主成分金属の融点 が、副記録層の少なくとも1層において、好ましくはす べての副記録層において、1000℃以下であることが 望ましい。なお、前記したようにAlとSbとは融点が 近いため、両層を同時に溶融させることは容易である。 【0033】また、記録時の反応を各主成分金属の融点 未満の温度で進行させる場合、すなわち固相反応により 拡散させる場合、各副記録層の主成分金属の融点が互い に近いことが好ましく、具体的には、各副記録層の主成 分金属の融点が幅200℃以下の温度域、特に幅100 ℃以下の温度域内に収まっていることが好ましい。各主 成分金属の融点が近ければ、すべての副記録層を活性な 状態にすることができるため、比較的速い速度で拡散が 進行する。前記したようにA1とSbとは融点が十分に 近い.

【0034】精頻症診験型の厚さ、すなわちずべての期記 参層の合計厚さは、3~50m、特に3~30mである ことが行ましい、精層記録期が得すざると、記述前談に おいて十分な反射率差を確保することが困難となる。一 方、精層記録層が厚すぎると、栽層記録層の熱容量が大 さくなるため、記録感度が悪くなる。

【0035】各副記録層の厚さは、1~30nm、特に2 ~30mであることが好ましい。副記録層が確すぎる と、記録前後において十分な反射率差を確保することが 難しくなる。一方、副記録層が厚すぎると、積層記録層 の全厚が大きくなりすぎるため、積層記録層の熱容量が 大きくなって記録感度が低くなってしまう。各副記録層 の厚さは、熱安定性が高く、かつ反射率差の大きい記録 マークが形成されるように適宜決定すればよい。例え ば、Al主成分層とSb主成分層とを組み合わせる場 合、AlとSbとが1:1で結合した金属間化合物が生 成すると考えられるので、積層記録層中におけるA1と Sbとの比率(原子比)が1:1から大きく外れないよ うに、各副記録層の厚さを設定することが好ましい。 【0036】A1主成分層とSb主成分層とからなる精 層記録層において、原子比Sb/A1は1/3~3、特 に2/5~5/2であることが好ましい。この原子比が 小さすぎても大きすぎても、反射率を低下させる混合物 が十分に生成しにくくなり、記録前後での反射率差が十分に大きくならず、その結果、十分に高いCNR(carrier to noise ratio)が得られない。したがって、Sb/Alが上記説開内となるように、Al主成分層の厚さとSb主成分層の厚さとの比を設定することが好まし

い。
(0037] A1主成分層とSb主成分層とを含む積層 記録層において、レーザービーム入射側から見て手前側 の層は、A1主成分層であってもSb主成分層であって もよい。未発明では、これらのいずれの場合であっても 記録および再生に支輝はないので、設計の自由度が高い、手前側の層をA1主成分層とすれば、未記録部にいて、設計の自由度が高いて高反射が小得られやすくなる。一方、手前側の層を Sb主成分層とすれば、記録処度を高くしやすくなる。 (0038] 本界明における解理記録層は、自から赤色までの広い彼長域において、記録外間記録の光学特性が変化するので、記録、押生用レーザービームの波長を広い波長域の必要形できる。

【0039】本発明における精層記録層は、熱的には安 定であるが、水蒸気やそのほかのガスに対しては十分に 安定とはいえない。そのため本発明の媒体では、積層記 録層を一対の無機保護層で挟んだ構造とすることが好ま しい、無機保護層は無機材料からなる。この無機材料と しては、酸化物、硫化物、窒化物、フッ化物、炭化物、 これらの混合物などの各種誘電体が好ましい。誘電体か らなる無機保護層を設けて光干渉効果を利用することに より、記録前後での反射率差を大きくすることも可能で ある。無機保護層の構成材料および厚さは、媒体の光学 的設計および熱的設計に応じて適宜決定すればよい。 【0040】また、本発明の媒体では、記録用レーザー ビーム入射側から見て、積層記録層より奥に反射層を設 けることが好ましい。反射層からの戻り光を利用するこ とで、記録前後での反射率差を大きくでき、また、記録 感度を高くすることが可能となる。 反射層は、金属(半 金属を含む) 膵や誘電体多層膜などから構成すればよ い。反射層の構成材料および厚さは、媒体の光学的設計 および熱的設計に応じて適宜決定すればよい。

【0041】また、座埃や摩託などの外的要素から媒体 を守るために、本発明の媒体の少なくとも一方の面に、 樹脂や硬度の高い無機材料などからなるトップコート層 やハードコート層を設けてもよい。

【0042】記録マーク形成により反射率が上昇するタイプ (Low to Hi 由タイア)では、記録前における反射率が低いため、記録する前はトラッキングサーポ信号、フォーカシングサーポ信号がわらい。また、プリビットにおける反射率はさらに低いため、プリビットが保持すの媒体は、記録マーク形成により反射率が低下するタイプ(関係)は、記録マーク形成により反射率が低下するタイプであることが好ましい。本売明において積層記録量をAI主成分階とちし主成分階といました。

(7) 開2003-54135 (P2003-5pA)

から構成した場合、記録マークの反射率を未記録報域の 反射率より低く設定しやすい。ただし、本発明を造満型 の媒体や高反射を必要としない媒体に適用する場合に は、Low to Hishタイプであってもよい。A 1 主成分層 とSD主張分層とを組み合わせた場合でも、誘葉体層に よる光干渉効果を利用されば、Lowto Hishタイプとする ことができる。

【0043】次に、多層光記録媒体に本発明を適用する 場合について説明する。

【0044】多期が記録維体は、複数の記録層が、記録 一再生用レーザービームに対し透明性を有する透明中間 配を介して積度された構造をもち、他の記録解を通して 照射されるレーザービームによって記述・用生が行われ る記録層が存在する媒体である。この多層光記録媒体に 本売明を適用する場合には、記録層の少なくとも1つ を、前記積層記録層とする。なお、そのほかの記録層 は、例えば相致代型の記録層であってもよく、プリビットを有する反射程からなる再生専用型の記録層であって もよく、特に限定されない。

【0045】従来、複数の相変化型記録層を積層した多 層光記録媒体が提案されている。相変化型記録層では、 レーザービーム照射により結晶質記録層を溶融し、これ を無冷することにより非晶質記録マークを形成する。記 録層を急冷するためには、記録層近傍に金属からなる放 熱層を設けることが一般的であり、冷却速度を速くする ためには放熱層を厚くする必要がある。しかし、放熱層 を厚くすると、放熱層の光透過率が低くなってしまうた め、多層光記録媒体には不適当となる。また、相変化型 記録層を備える多層光記録媒体において、すべての記録 層でジッタを小さくするためには、各記録層ごとに記録 時の記録パルスストラテジを最適に制御する必要があ り、また、各記録層ごとに熱設計を最適化する必要があ るので、煩雑である。なお、記録パルスストラテジと は、記録用レーザービームのパワー制御パターンを意味 する。一般に、相変化型光記録媒体に記録する際には、 記録用レーザービームを記録マークの長さに対応して連 綾的に照射するのではなく、例えば特開平9-7176 号公報に記載されているように、記録マーク形状の制御 のため、複数のパルスからなるパルス列として照射し、 かつ、パルス列中の各パルスの福を厳密に制御する場合 が多い。この場合のパルス分割の具体的構成を、一般に 記録パルスストラテジと呼ぶ。

[0046] これに対し本条明で用いる前記機能と終層 は、複数の金属層を瞬時に溶離させるだけで記録マーク を形成することができ、冷却速度を考慮する必要がな い。そのため、前記然無限を設ける必要がない。また 記録がワーマーンが広い。また、高差記録が可能であ る。また、記録がパルストラテジを被断に制御する必要 がない。また、熟録がパルストラテジを被断に制御する必要 がない。また、熱致計し関する自由度が高い。したがっ て、前写機構態を操作し、多形光が複数化に変してが 特に、他の記録層の記録/再生に用いるレーザービーム が透過する記録層(最適である。したがって、このよう な記録層のうちの少なくとも1層を、前記積層記録層と することが舒ましい。

【0047】多層/記録媒体では、レーザービーム入射 棚表面に近いものは2と記録層を薄くして、光透過率を高 くする設計とすることがある。その場合、各記録側ごと に然容録や光板収率が異なることになり、そのため、記 整速度と異なることになる。各記録解が相変化型記録層 である場合には、各記録解ごと記録がルスストラテジ を厳密・開酵することにより、各層における記録速度の 源いと循度する必要がある。

【0048】一方、前記積層記録層からなる記録層では 記録パルスストラブの削粉が実質的に不要であるた 、記録用レーザービームのエルギーの機能だけを削 物すれば記録整度の違いを補償できる。したがって、特 使のマーク長の信号を記録するに際し、すべての記録層 において記録/10人ストラデンを同一とし、かつ、各記 対象型ごとに記録用レーザービームのパワーと最速に制御 するという単純を削欝方法が利用できる。また、例えば 複数の記録層中に相変化型記述順が存在する場合には、 記録いれスストラデジはその相変化型記録層に対応する ものに固定し、記憶権を記録するといまでは記録用 レーザービームのパワー制御により対応することによ り、相変化型記録層および前記積周記録者 いすたも数々な可能が行きる。

【0049】また、記録用レーザービームのエネルギーの総量を制御するために、パルス分割した記録用レーザービームのデューディー比を制してもよい、すなわち、特定のマーク長の信号を記録するに際し、すべての記録網において記録用レーザービームのパワーを同一とし、かつ、各記録層ごとに記録用レーザービーム開射時間を最潔に創酵する方法を利用してもよい。

【0050】なお、隣接する記録マーク間における記録 用レーザービームのパワーは特に限定されない、適常、 DVDーRのような追記型の媒体では、記録マーク間に おける記録用レーザービームのパワーは、トラッキング が可能な程度(再生パワーと同程度)まで落とされる。 一方、DVDーRWのようなオーバーライトが可能な書 き換え螺体では、隣り合う記録マーク間における記録パ リーザービームのパワーは、消去パワーに相当で オープ・ロースのパワーは、消去パワーに相当で 対しては、これらのいずれのパワー制御パターンを利用 してもよい、

[00651]多層光記録線体では、サーボ信号やプリビットによる信号の強度を名記録層で揃えるために、各記録層の記録線の反射率の432同じであることが算ましい。具体的には、任意の2層の記録層を選択し、一方の反射率を R_n とし、他方の反射率を R_n とし、他方の反射率を R_n としたとき、 $2/3 \le R_n/R_n \le 3/2$

(8) 開2003-54135 (P2003-50譯繳

であることが射ましい。前記模層記録層は厚さ制御による透過率の調整が容易であり、また、前記限層記録層に加えて誘電体層および/または反射層を設けることにかり変重反射条件を容易に制御できる。したがって、本発明を適用した多層光記録媒体では、 $R_{\rm H}/R_{\rm H}$ が上記範囲

となるように反射率を備えることが容易にできる。 (0052)多層光記録媒体において、他の記録層の記 録《再生に用いるレーザービームが活動する構態記録層 は、原をが好ましくは3~15ms、より好ましくは3~ (10mである。程すぎると、記録前後において十分2~ 射率差を確保することが思難となる。一方、厚すぎる と、光清過率が低くなるため、前記他の記録層の記録/ 軍士に服務響を考える。

【0053】ところで、記録層の光反射率を記録前においてR。記録後においてR。とし、記録層の光吸収率を記録前においてA。記録後においてA。とし、記録層の光透過率を記録前においてT。記録後においてT。とすると、

式 I $R_B + A_B + T_B = R_A + A_A + T_A = 1$

が成立する。多層/記録媒体において、他の記録側で 後/再生に用いるレーザービームが適当する記録側で は、配録前後の透過率が3は同じ (T₁ ≒ T₆) であるこ とが舒えしい。記録前後で選過率が異なると、その記録 周の記録状態になって記録/再出が行われる記録網の記録感 度および反射率が影響を受けるからてある。また、前述 したように、光記機解体は割め しいゆイブ (R₆>R 3) であることが好ましく、これは多層光記録媒体にお いても同様やある。

【0054】Al主成分層とSb主成分層とを有する前 記積層記録層は、照由 to Louタイプ(R₃>R₄)とな る設計において記録前後の透過率をほぼ同じ(T₃≒ T₄)にすることが容易にできるので、多層光記録媒体 に好適である。

【0055】ところで、「1,4 T」かのR₂ンFl₄である場合、前記式1からA₅<A₈となる。すなわち、記録マークの吸収率が、未記録都の吸収率よりも高くなる。したがって、レーザービーム原供物に、記録マークの温度が未記録者の温度より高くなる。そのため、記録マークの温度が高くなり、その結果、記録マークの原射率が強くなり、その結果、記録マークの反射率が強くにし、信頼性に問題が生じることがある。これで対し本発明で用いる機構定機構は、前記したように記録マークの反射率の無安定性が高い。そのため前記機構記記録層では、「1,4 T」で、1,4 T」で、1,4

【0056】多層光記録媒体において $T_B = T_A$ とする場合、具体的には T_a / T_a が

 $5/6 \le T_B/T_A \le 6/5$

の範囲内にあればよい。TR/TAが小さすぎても大きす

ぎても、他の記録層の記録感度や反射率に与える影響が 大きくなる。なお、「18および「16は、光干渉効果により 制御できる。具体的には、積層記録層の前後に無機保護 層 (誘電体層)を設け、その光学特性および厚さを制御 すればよい。

(10057] 一方、他の記録層の記録/再生に用いるレーザービームが認めしない環帯記録層、すなわち、レーザービーム人射面から最も遠くにある機需記録層、大きに野雄するとしていたし、この機層記録網は、そこに野雄するレーザービームの強度か全記録解中で最も低いなか、記録感度が高い必要がある。したかった、熱容量を小さくするために、この機層記録層は厚さ25m以下ますることが好ましい。また、この機層記録層のの反射技は、船の記録層によって被索するため、この機層記録層は及射率が高いことが好ましい。したがって、レーザービーム人射間側から見て、この機層記録解の後の間に対した反射構造けることが好ました。また、反射層を設ければ、この機層記録層に戻る記録用レーザービームの量が多くなるので、見かけ上、記録感度を向とせることができることができることができることができることができるととができる。

[0058]

【実施例】 実施例1 サンブルNo.101

以下の手順で図1に示す構造の光記録ディスクサンブル を作製した。

[0059] 基体とには、射出成形によりグループ(深さ40m)を同時成形した電径120m。厚さ0.6m のポリカーボネートを用いた。この速体2において、グループ記録方式における記録トラックビッチは0.74 ループの表。この基体2上に、Ar 雰囲気中において、バック法により第1該電休用31、積層記録層4、第2 誘電に振り22はパトップコート層6をこの順で形成した。

【0060】第1誘電体層31は、厚さ80nmとし、組成はZnS-SiO₂(ZnS:80モル%、SiO₂:20モル%)とした。

【0061】積層記録層4は2層構造とし、第1誘電体 層31側から、

副記録層41:厚さ10nmのSb層、

副記録層42:厚さ10nmのAl₉₈Cr₂(原子比) 層、

とした。この積層記録層中において、原子比Sb/AlはO.54である。なお、この原子比は、密度と副記録 層の厚さとから算出した値である。

【0062】第2誘電体層32は、厚さ50nmとし、ZnS・ SiO_2 ターゲット(ZnS・80モル%、 SiO_2 : 20モル%)を用いてAr雰囲気でスパッタ法により形成した。

【0063】トップコート層6は、紫外線硬化樹脂をスピンコートにより塗布後、紫外線照射により硬化して形

(9) 開2003-54135 (P2003-56途線

成した。硬化後のトップコート層6の厚さは5μmであ った。

【0064】サンプルNo.102

精層記録層4を除き、サンプルNo.101と同様にして 作製した。積層記録層4は2層構造とし、第1誘電体層 31側から、

副記録層41:厚さ7nmのAlagCr, (原子比)層、 副記録層42:厚さ13nmのSb層.

とした。この積層記録層中において、原子比Sb/Al は1.01である。

【0065】比較サンプルNo.103

精層記録層4を除き、サンプルNo.101と同様にして 作製した。積層記録層4は2層構造とし、第1誘電体層 31側から.

周記録層41:厚×10mのTe層。

副記録層42:厚さ10nmのA1ggCr2(原子比)

とした.

【0066】比較サンプルNo.104

精層記録層4を除き、サンプルNo.101と同様にして 作製した。積層記録層4は2層構造とし、第1誘電体層 31側から、

副記録層41:厚さ10nmのGe層、

副記録層42:厚さ10nmのAloccr。(原子比) 層、

とした。

【0067】評価

上記各サンプルについて、光ディスク評価装置を用い、 基体2を通してレーザービームを入射させて特性評価を 行った。

【0068】測定条件

レーザ波長:634nm、

開口率NA:0.6、 線速度: 14m/s.

再生パワー: 0.9 刷

【0069】レーザービームの照射により、それぞれ長 さ1.87 μmのマークとスペースとからなる単一信号 を記録し、マークに対応する記録部とスペースに対応す る未記録部とからなる記録マーク列を形成した。次い で、この記録マーク列のCNR (carrier to noise rat io) を測定した。また、各サンプルを80℃、80%R Hの恒温恒温槽に50時間保存する保存試験を行い、そ の後にCNRを測定した。初期CNRと保存後のCNR

とを表1に示す。 [0070]

【表1】

	表 1		
サンプル	CNR (dB)		
No.	20318	50 時間後	
101	61.1	61.0	
102	62.2	62.2	
103(比較)	58.5	53.0	
104(比較)	60.5	54.6	

【0071】表1において、サンプルNo.101、No.1 02は、保存試験によりCNRは劣化していない。ま た、保存時間を200時間に延長して同様な測定を行っ たときも、CNRは劣化しなかった。この結果から、本 発明サンプルは保存信頼性が良好であることがわかる。 一方、比較サンプルでは、保存試験によりCNRが劣化 している。また、保存試験の前後において各サンプルの 記録部および未記録部の反射光量を測定したところ、本 発明サンプルでは反射光量に変化は見られなかったが、 比較サンプルでは記録部の反射光量が変化した。この結 果から、比較サンプルでは記録部の状態が変化したため にCNRが劣化したことがわかる。

【0072】また、上記各サンプルに対し、上記記録マ ーク列を形成した後、CNRを測定し、次いで、サンプ ルを回転させながら、記録マーク列に出力3mlの直流レ ーザービームを1分間照射した後、CNRを測定した。 この場合も、サンプルNo.101、No.102ではCNR の劣化は見られなかった。この結果から、本発明サンプ ルは再生耐久性が良好であることがわかる。一方、比較 サンプルNo.103、No.104ではCNRが劣化した。 【0073】このとき比較サンプル%、103では、記 録部、未記録部とも反射光量に変化が見られたので、未 記録部で拡散・混合が生じると共に、記録部の状態が変 化したことがわかる。一方、比較サンプルNo. 104で は、記録部の反射光量にだけ変化が見られた。すなわ ち、両比較サンプルでは、記録部の状態が変化したこと がわかる。また、比較サンプルNo.103では一方の副 記録層をTeから構成しており、Teは融点が450℃ と比較的低いため、未記録部でも拡散・混合が進行した レ老えられる.

【0074】以上から、Sb主成分層とA1主成分層と を副記録層として用いた場合のみ、記録部が熱的に安定 であることがわかる。これに対し、Al主成分層と、T eやGeを主成分とする層とを組み合わせた場合には、 記録部が熱的に安定ではないことがわかる。これは、A 1とTe、および、A1とGeでは、安定な結合が形成 されないためと考えられる。AlとGeとは共融混合物 (共融点424℃)を形成しうる組み合わせである。ま た、A1とTeとは、準安定な金属化合物であるAl。 Teoを形成しうる組み合わせであるため、高温下での 保存または室温での長期間の保存により相分離または構 造変化が生じると考えられる。

(10) #2003-54135 (P2003-5F)A)

【0075】なお、サンプルNo.101、No.102、比較サンプルNo.103は出まり しいタイプであったが、比較サンプルNo.104は加め th 出身タイプであった。【0076】記録部の状態を分析するために、スライドガラスを基体2とし、この上に、サンブルNo.101と同様にして第1誘電体層31、積層部接層4、第2誘電体層32を形成して、分析用サンプルとした。第1誘電体層31および第2誘電体層32は不ぞれ厚さ20mとし、機関電影網とは、5D層の厚さを100mとし、AlasCr.層の原さを100mとし、AlasCr.層の原さき100mとし、AlasCr.層の原さき100mとし、

【0077】この分析用サンアルを500でで5分間熱 処理し、この熱処理の前後において薄膜、経過所により 解析を行った、その結果、熱処理輸は5bのピークとA 1のピークとが見られたが、熱処理線は、熱処理線には 存在していなかったA1Sbの(111) 面を示すビー クがメインピークとなっていた。この結果から、Sb主 成分層とA1主衆分層と各層周した循層配験層々では、 加熱によって拡散が生じて、安定な金属間化合物である A1Sbが形成されることがわかる。

【0078】なお、熱処理後のサンブルに対し再度50 0℃で5分間熱処理を行ったが、X線回折図形に変化は 見られなかった。この結果から、SbとA1とが混合さ れた状態は、Sb主成分層とA1主成分層とが積層され た状態よりも熱的に安定なことがわかる。

【0079】実施例2

誘電体層および反射層による効果を調べた。

【0080】サンプルNo.201

図2に示す構造から第2誘電体層32および反射層5を 省いた構造のサンプルを、以下の手順で作製した。

【0081】基体2には、サンプルNo.101と同じものを用いた。

【0082】第1誘電体層31は、厚さ60mmとし、組成はZnS-SiO₂(ZnS:80モル%、SiO₂:20モル%)とした。

【0083】積層記録層4は2層構造とし、第1誘電体層31側から、

副記録層41:厚さ7nmの Al_{98} Cr_{2} (原子比) 層、副記録層42:厚さ13nmのSb層、

とした。 【0084】トップコート層6は、サンプルNo.101 と同様にして形成した。

【0085】サンプルNo.202

サンプルN0.201の積層記録層4とトップコート層6 との間に、第2誘電体層32を設けた構造とした。第2 誘電体層32は、厚さ50m2とし、組成はZnS-Si O_2 (ZnS:80 Ξ nW8、Si O_2 :20 Ξ nW8)とし

【0086】サンプルNo.203

サンプルNo.202の第2誘電体層32とトップコート 層6との間に、反射層5を設けた構造とした。反射層5 は、厚さ50nmとし、組成はAlgsCr2(原子比)と した。

【0087】評価

これらのサンプルに対し、マークおよびスペースをいずれもの・4 μeとしたほかは実施例1と同様にして記録マーク列を形成した。次いで、保存時間を200時間としたほかは実施例1と同様にして保存試験を行い、保存信頼を言評価した。初期CNRと保存像のCNRとを表名に示す。

[8800]

【表2】

£0398	200 時間後	
54.9	51.9	
55.1	55.1	
55.8	55.6	
	55.1	

【0089】表2において、積層記録層4を第2該電体層32で保護したかったサンブルル。201は、保存試 解えりで18万分を化している。この結果から、指す 原作すの18万分を化している。この結果から、高温条 件下での9個形式機関の実化が切えられることがわかる。 【009個形式と関係して記録マーク列を形成し、記録部お よび未定録部の反射光量と記述りワーとの関係を課べ ・ 無知を図えてきす。

た。結果を図3に示す。 【0091】図3に示されるように、反射層を設けた場 合、戻り光を利用することによって記録部と末記録部と の反射率差 (再生信号出力) が大きくなることがわか る。また、反射層を設ければ、記録パワーが小さいとき でも大きな反射率差が得られることがわかる。 【0092】また、上記記録マーク列を形成したサンプ ルNo. 203について、反射層5とトップコート層6と をテープにより剥離した後、クロロホルムにより基体2 を溶解して除去した。この状態の積層記録層4に対し、 透過型電子顕微鏡による観察および電子線回折を行っ た、その結果、未記録部では、S b 結晶相を示す同折パ ターンとA1結晶相を示す回折パターン(A1(11 1)面のピーク)が観察された。一方、記録部ではこれ らの回折パターンが観察されなかった。この結果から、 記録部ではA1とSbとの混合物がレーザービーム照射 により生成されたことがわかる。また、記録部ではSb とA1とが溶離した痕跡が見られた。この結果から、レ ーザービーム照射部位では積層記録層が厚さ方向の全体 にわたって溶融し、溶融拡散が生じたことがわかる。 【0093】上記記録マーク列を形成した上記各サンプ ルに対し、出力 7mWの直流レーザービームを 1 回照射し たところ、記録部の反射光量は変化しなかったが未記録

部の反射光量は低下した。このことから、記録部の混合

(11) \$2003-54135 (P2003-50A)

物のほうが、記録前の積層状態よりも熱的に安定である ことがわかる。

【0094】また、上記記録マーク列を形成したサンア ル約。203を、レーザ級長432mの光ディスク評価 装置で再生したところ、未実験部の反射率32% 変調 度65%であった。一方、レーザ波長634mでは、未 記録部の反射率19%、変調度70%であった。この結 果から、本売明の媒体は記録/再生用レーザービームの 波長を広い波長域から選択できることがわかる。 【0095】実験例3

図4に示す構造の光記録ディスクサンプルを、以下の手 順で作製した。

【0096】ボリカーボネートからなる直径120m、厚さ0.6mの支持基体20上に、Ar雰囲気中でスパッタ法により反射層5、第2誘電体層32、機層記録層4および第1誘電体層31を順次形成した。

【0097】反射層5は、厚さ50mmとし、組成はAg g8Pd₁Cu₁(原子比)とした。

【0098】第2誘電体層32は、厚さ50nmとし、組成はZnS·SiO₂(ZnS:80モル%、SiO₂: 20モル%)とした。

【0099】積層記録層4は2層構造とし、第1誘電体 層31側から、

副記録層41:厚さ14nmのAigg C r 2(原子比) 層

副記録層42:厚さ14nmのSb層、

とした。この積層記録層中において、原子比Sb/AI は0.54である。

【0100】第1誘電体層31は、厚さ70nmとし、組成は $ZnS-SiO_2$ (ZnS:80モル%、 $SiO_2:20$ モル%)とした。

【0101】このサンブルの新1誘電休開31間から、 炭展810m。上一丸ズボット部100μmのリー 炭展810m。上一丸ズボット部100μmのリー 様空航海機械(記録マークと同じ状態)を形成した。次 様空航海機械(記録マークと同じ状態)を形成した。次 で、 影線域域と転換構像とにかけ、第1誘端体開 31間からエッチングを行いながらオージニ電子分光に より元素分析を行った。この分析により得られた、積層 記録機度が方向におけるSbおよびA1の分布を、図5 および関心にそれぞれ示す。図5およじ図6は、オージ 宝電子分光におけるエッチング時間と元素消度(単位時間 あたりのカウント)との関係を示すグラフであり、図 5は、記録領域における元素分布、図6は未記録領域に おける元素分布である。

【0102】図5と図6との比較から、レーザービーム 脈射によりSbとA1とが3279一に混合したことがわ かる。ところで、前記特開2000-187884号公 報では、レーザービーム照料により、第10記録層構成 元素の濃度と第2の記録層構成元素の濃度とが逆転する 現象を利用することが記載されている。これに対し本発 明では、同公報記載の発明と異なり、図5に示すように レーザービーム照射部位において元素分布が隔らず安定 した混合状態となるため、十分な保存信頼性が得られ る

【0103】実施例4

以下の手順で図7に示す構造の多層光記録ディスクサン アルを作製した。このサンアルは、支持基体20上に、 反射層5。第1データ層DL-1、透明中間周間し、第 2データ層DL-2および基体2を有し、レーザービー ムは基体2を通して入射する。各データ層は、レーザー ビーム入射側から見て、第1講電体周1、副記録層4 1、42、第25線域末周32をこの順に有する。

[0104] 支持基件20には、射出炭形によりグループ (深さ40m) を同時成形した直径10m。 戻寸 1.1mmのポリーカーボートを用いた。この支持基件20において、ランド・グルーブ記録方式における記録トラックセッチは0.3μπである。この支持基件20上に、Ar 雰囲気中においてスパッタ法によりデータ層Dレーフまでの多層を形成した。

【0105】反射層5は、厚さ50mとし、組成はAg 88 Pd₁Cu₁(原子比)とした。

【0106】第1 $^{-}$ ク層DL $^{-}$ 1 において、第1誘電 休層 $^{-}$ 1 は原さ $^{-}$ 7 $^{-}$ 7 $^{-}$ 2 は原さ $^{-}$ 7 $^{-}$ 2 は原さ $^{-}$ 9 $^{-}$ 2 は原さ $^{-}$ 9 $^{-}$ 2 $^{-}$ 2 $^{-}$ 8 $^{-}$ 8 $^{-}$ 2 $^{-}$ 2 $^{-}$ 8 $^{-}$ 8 $^{-}$ 2 $^{-}$ 8 $^{-}$ 8 $^{-}$ 2 $^{-}$ 8 $^{-}$ 8 $^{-}$ 2 $^{-}$ 8 $^{-}$ 8 $^{-}$ 9 $^{-}$ 2 $^{-}$ 8 $^{-}$ 9 $^{-}$ 2 $^{-}$ 9 $^{-}$ 2 $^{-}$ 9 $^{$

副記録層41:厚さ4nmのAlggCr2(原子比)層、 副記録層42:厚さ6nmのSb層、

とした。この積層記録層中において、原子比Sb/A1は0.82である。

【0107】透明中間層下しは、紫外線硬化樹脂をスピンコートにより塗布後、グループパターンを有するスタンパで押圧しながら紫外線頭側により硬化して形成した。なお、このグループパターンは、支持基体20上のグループパターンと同じとした。硬化後の透明中間層下しの層とは20加であった。

【0108】第2データ層DL-2において、第1誘電 体層31は厚さ45m。第2誘電体層32は厚さ65m とし、組成はいずれもZnS-SiO₂(ZnS:80 モル%、SiO₂:20モル%)とした。また、 副記録層41:厚さ3mののAl₂Cr_r(原子比)層、

御記録暦41:厚さ5mのAlggに下2(原士氏)層、 副記録暦42:厚さ5mのSb層、

とした。この積層記録層中において、原子比Sb/Alは0.91である。

【0109】次いで、 第2データ層DL-2上に、集外 線硬化樹脂をスピンコートにより途布し、集外線照射に より硬化して基体2を形成した。硬化後の基体2の厚さ は90µmであった。

【0110】評価

このサンプルについて、光ディスク評価装置を用い、以 下の条件で各データ層のグループ内にランダム信号を記

(12) #2003-54135 (P2003-50zA)

録して、反射率およびジッタを測定した。

【0111】測定条件

レーザ波長:405nm、

開口率NA:0.85、 記録信号:1-7変調(ビット長0,13μm)、

記録線速度:11.4m/s、 再生線速度:6.5m/s、

記録パワー:表3に示す値、

記録パワー:表3に示す: 再生パワー:0.5ml

[0112]記録がルストラデジは、17信号のパルス数がn-1となる2値パルス列を用い、先頭パルスの編は0.67、それ以外のパルスの編は0.57とした。すなわち、27信号はパルス数1とし、87信号はパルス数7とし、パルス間におけるパワーは上配再生パワーとした。

【0113】測定結果を表3に示す。なお、表3に示す ジッタはクロックジッタである。このクロックジッタ は、再生信号をタイムインターパルアナライザ(横河電 機株式会社製)により測定して「信号の揺らぎ(σ)」 を求め、検出態幅をTwとして、

σ/Tw (%)

により算出した。クロックジッタが10%以下であれば、信号品質に問題はないといえる。

【0114】 【表3】

> 表 3 記録パワー 反射率(%) *2*v# (mW) (%) DL-1 3,5 10.7 4.2 9.5 DL-2 7.0 11.3 4.6 9.3

【0115】表3に示すように、記録前(未記録部)の 反射率は両データ層でほぼ等しく、いずれも10%以上

と十分に高い。そのため、両データ層共に、トラッキン

グエラー信号などのサーボ信号の出力が十分に高かっ た。また、両データ層共に、High to Lowタイプであ り、記録部で反射率が4%程度まで低下しており、変調 度は60%程度で再生信号出力が十分に高くなってい る。また、両データ層に記録する際に、記録パルススト ラテジは同じものとし、記録パワーだけを制御すること により、いずれのデータ層においてもジッタが10%以 下となり、良好な信号品質が得られている。 【0116】第2のデータ層DL-2に、数ミリメート ルの幅でランダム信号を記録し、記録前後の透過率を比 較した。その結果、記録前の透過率T。は49%、記録 後の透過率Taは50%であった。すなわち、この第2 のデータ層DL-2は、透過率が記録によってほとんど 変化しない。また、第2のデータ層DL-2にランダム 信号を記録する前に、第1のデータ層DL-1に対し記 録および再生を行い、ジッタを測定した。さらに、第2

のデータ周DL-2にランダム信号を開始した核にも、第1のデータ周DL-1に対しジックを測定した。この とき、第2のデータ周DL-2の記録能を透過させて、 第1のデータ周DL-1にレーザービームを照射した。こ れらの測定により得られた記録パワーとジックを開かした。 (4) では、100円の関係を、関名のデータ周の記録態度はよいて、第1のデータ周の記録態度はよいで、第1のデータ周の記録を表は、第1 ジックはそれぞれ間等であることがわかる。また、第1 のデータ周DL-1の反射率および信号のエンベロープ も、第2のデーク周DL-2への記録はよってほとんど、数種を受けなかった。これらの記録はよってほとんじ事での記録によってほとんど変化しない場合、多層記記録 媒体において安定した記録/再生特性が得られることが 明らかである。

【0117】第1のデータ層DL-1に対する配金の際に、先頭がいスの幅を 0.3 下に、それ以外のバルスの幅を 0.3 下に、それ以外のバルスの 6年を第2のデータ層への配縁時と同じ 7.0 mに変更したところ、ジッタは9.8 2%となり、やはり良好な信号出版 7.0 体長力に、記録パワーを固定した状態で記録用レーザービー A原規時間だけ前側すれば、ジッタを十分に小さくできることがわかる。

[0118] この実施例におけるデーク配送レートは、 記録時70 Mps。 再生時40 Mbssに相当する。また、記 総容量は、2層のデーク層全体で456以に達する。この データ転送レートおよび記録容量は、現在実用化されている光ディスクに対し著しく大きい、しかも、記述時の 上記データ配送レートは、光ディスク腎経薬菌の 駅前かの性能限界によって決定されたものであり、本発 明サンプルにおける限界ではない、すなわち未発明サン アルは、より高いデータ転送レートを実現するボテンシャルをもっている。

【0119】なお、データ層の光透過率を10%以上向 上させたサンプルでも、記録が可能であった。この結果 から、本発明は3層以上の記録層を有する多層光記録媒 体にも適用可能であることが明らかである。

【0120】第1のデータ押DL-1にランダム信号を 証疑した後、譲速度を6.5m/sとして1.5mのレー ザービームを照射して再生を行ったところ、未記録部の 反射率がやや低下した。この反射率の低下は。協制反応 はより臨止器側で元素能動が上たを集と考えられ る。しかし、記録部では反射率突化は認められなかっ た。なま、この実験所では表別率突化は認められなかっ かンズにより短数長(後長入 405m)のレーザービ ムる悪財しているため、入/NAに比例するレーザビ ムスボット径はかなり小さい。そのため、出力1.5 mのレーザービームであっても、ビームスボット内にお ける単位面積当たりのエネルギーはかなり高くなる。 [0121]

(13) #2003-54135 (P2003-54"A)

【発明の効果】本発明では、保存信頼性および再生耐久 性が高く、また、記録、再生波長を広い波長域から選択 することが可能で、また、高速、高密度記録が可能な追 記型光記録媒体が実現する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用される光記録媒体の構成例を示す 部分断面図である。

【図2】本発明が適用される光記録媒体の構成例を示す 紹分斯面図である。

【図3】記録パワーと媒体の反射光量との関係を示すグラフである。

【図4】本発明が適用される光記録媒体の構成例を示す 部分断面図である。

【図5】積層記録層の記録領域におけるオージェ電子分 光分析の結果を示すグラフである。

【図6】積層記録層の未記録領域におけるオージェ電子 分光分析の結果を示すグラフである。 【図7】本発明が適用される多層光記録媒体の構成例を 示す部分断面図である。

【図8】図7に示す構造の媒体において、第1のデータ 層DL-1に対し記録/再生を行ったときの記録パワー とジッタとの関係を示すグラフである。

【符号の説明】 2 基体

20 支持基体

31 第1誘電体層

32 第2誘電体層 4 積層記録層

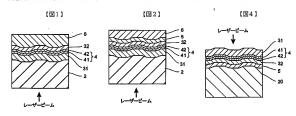
4 慎層記錄層

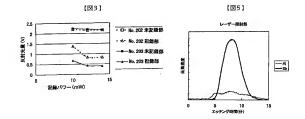
41、42 副記録層

5 反射層

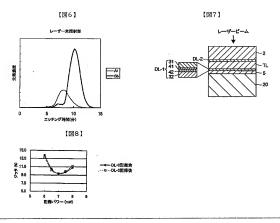
6 トップコート層 DL-1. DL-2 データ層

TL 透明中間層





(14) 〒2003-54135 (P2003-5u(繊



フロントページの続き

(72)発明者 栗林 勇 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内 F ターム(参考) 2H111 EA03 EA12 EA21 EA32 EA33 EA40 EA41 EA43 FA02 FA14 FA24 FB09 FB21 FB30 5D029 JA01 JB03 JB17 JC17 5D090 A401 EB03 EB12 CO01 DD01 EB02 KN03 5D119 A423 BA01 EB02 HA47 HA60